

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0207U000091

Державний реєстраційний номер: 0104U003107

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-01-2007

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження та розробка сегнетоелектричної енергонезалежної пам'яті з неруйнівним зчитуванням

Початок етапу: 01.2004

Закінчення етапу: 12.2006

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Факультет інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України "КПІ"

Код за ЄДРПОУ: 24571500

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 454-9335

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження та розробка сегнетоелектричної енергонезалежної пам'яті з неруйнівним зчитуванням

Назва роботи англійською:

Research and development of ferroelectric non-volatile memory with not destroying reading

Реферат українською:

Удосконалені технологічні процеси отримання тонких сегнетоелектричних плівок та надмілких р-п переходів шляхом використання УЗ коливань. Розроблені нові структури енергонезалежних сегнетоелектричних елементів з неруйнівним зчитуванням на п'єзотрансформаторах та сегнетоконденсаторах з проектними нормами 0,2-0,4 мкм, та швидкодією 5-10 нс. Отримані тестові зразки сегнетоелектричної пам'яті на кремнієвих пластинах з КМОН схемами. Отриман патент України.

Реферат англійською:

Processes of thin ferroelectric films and supershallow p-n junctions by usage ultrasound are improve. New structures of non-volatile ferroelectric elements with not destroying reading on piezoelectric transformers and ferrocapacitors with design rules 0,2-0,4 microns and 5-10 nanoseconds high-speed performance are developed. Test samples of ferroelectric storage device on silicon wafers with CMOS structures are gained. The patent of Ukraine is obtain.

Індекс УДК: 531.76.084/.085; 621.317.76.084/.085, 621.315.434; 681.327.66

Коди тематичних рубрик: 59.33.33

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Самофалов Костянтин Григорович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Мартинюк Я.В., Оліх Я.М., Романюк Б.М. та ін. Акусто-стимульована релаксація механічних напружень в структурах Six-1Gex/Si при імплантації іонів He/ Тез. доп. міжн. наук. техн. конф. "Сенсорна електроніка і

мікросистемні технології"/м.Одеса,1-5 червня 2004 р.,с.161; Козерук С.А., Мартинюк А.Я., Петрищев О.Н. Исследование несимметричного биморфного пьезоэлектрического элемента в режиме излучения ультразвуковых колебаний.//Электроника и связь, 2005. № 26; Самофалов К.Г., Мартинюк Я.В., Верба О.А. та ін. Сегнетоелектричний енергонезалежний запам'ятовуючий пристрій з неруйнівним зчитуванням. Патент України №18752 від 15.11.2006 р.

Х. Заключение відомості

Керівник юридичної особи

Павлов Олександр Анатолійович

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

